# Лабораторная работа по квантовой электронике

# № 23 Инжекционные полупроводниковые лазеры

Яромир Водзяновский Б04-855а

# 1 Введение

#### 1.1 Цель работы

- 1. Измерение спектральных характеристик лазера и светодиодов, их дальнейший анализ
- 2. Получение зависимости мощности излучения светодиодов и лазера от мощности накачки (Ватт-ваттаная характеристика)

### 1.2 Суть работы

#### 1.2.1 Спектральная характеристика

- 1. Исследуем зависимось спеткра излучения инжекционного полупроводникового лазера/светодиодов от мощности накачки производится, измерив детектируемую длину волны и фиксируя напряжения при постоянной мощности накачки.
- 2. Определим характер изменения формы спектральной характеристики от установленной мощности накачки для лазера.

### 1.2.2 Ватт-Ваттная характеристика

1. Получим зависимости мощности излучения от мощности накачки для светодиодов и лазера поточечно меняя ток и напряжение накачки.

# 2 Эксперимент

## 2.1 Спектральные характеристики

1. Зависимость аплитуды излучения лазера от длины волны при разных токах накачки.

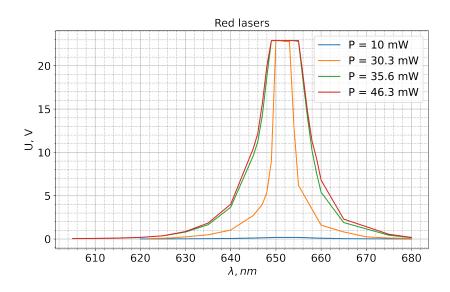


Рис. 1: Характеристика лазера при разных мощностях накачки

При уменьшении накачки аплитуда выходного излучения падает, чем больши накачка - тем шире полосагенерации.

# 2. Зависимость аплитуды излучения диодов от длины волны при разных токах накачки.

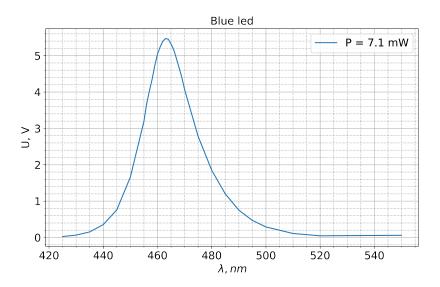


Рис. 2: Характеристика синего диода

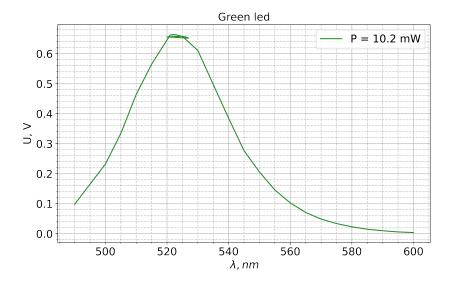


Рис. 3: Характеристика зеленого диода

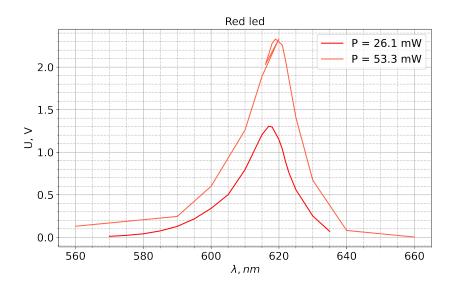


Рис. 4: Характеристика красного диода

Соответсвующи приблизительные максимумы излучения: красный 617, зеленый 522, синий 462 nm.

# 2.2 Ватт-ваттные характеристики

#### 1. Зависимости амплитуды выходого сигнала от мощности накачки для двух лазеров

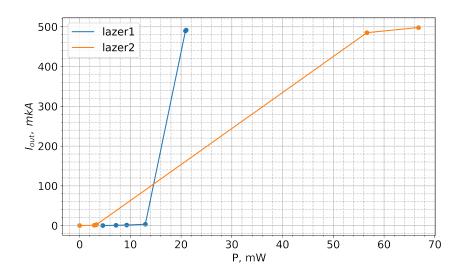


Рис. 5: В-В зарактеристика лазеров

На гарфике видим три участка участка: недостаток накачки, линейная зависимость, насыщение. Определим характерные значения накачки.

- Пороговая мощность  $P_{\Pi \mathrm{Op}} \approx \mathbf{12} \,\mathrm{MBt}; \, \mathbf{4} \,\mathrm{MBt}$
- Мощность насыщения  $P_{\mathrm{Hac}} \approx \mathbf{21} \; \mathrm{мBt}; \; \mathbf{60} \; \mathrm{мBt}$

# 2. Зависимости амплитуды выходого сигнала от мощности накачки для трёх диодов

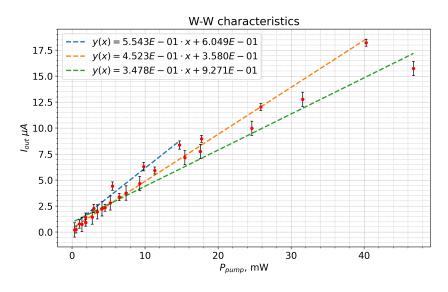


Рис. 6: Анимэ на картинке

В-В характеристика диодов имеет линейный вид,  $K\Pi Д$  каждого определяется как коэффициент наклона линейного фита, коэффициенты в таблицах (1,2,3)

Таблица 1: Коэффициенты аппроксимации Синего диода

| coeffs | coeffs_values | standard error | relative se, $\%$                      |
|--------|---------------|----------------|--|
| a_0    | 5.543E-01     | 1.715E-03      | $3.094\text{E-}01 \\ 1.686\text{E+}01$ |
| a_1    | 6.049E-01     | 1.020E-01      |  |

Таблица 2: Коэффициенты аппроксимации красного богатыря

| coeffs | coeffs_values | standard error | relative se, % |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| a_0    | 4.523E-01     | 1.139E-04      | 2.518E-02      |
| a_1    | 3.580E-01     | 3.985E-02      | 1.113E+01      |

Таблица 3: Коэффициенты аппроксимации зеленого диода

| coeffs | coeffs_values | standard error | relative se, $\%$ |
|--------|---------------|----------------|-------------------|
| a_0    | 3.478E-01     | 2.382E-04      | 6.849E-02         |
| $a_1$  | 9.271E-01     | 8.325E-02      | 8.979E + 00       |

# 3 Выводы

- Рост мощность накачки увеличивает ширину спектра излучения лазера, не меняя частоту генерации;
- Рост мощность накачки увеличивает ширину спектра излучения диода, снижая частоту генерации;
- Лазер имеет наименьшую ширину спектра излучения при сравнимых мощностях накачки;
- Диоды имеют линейную ватт-ваттную характеристику;
- Лазер имеет линейную BBX в диапазоне мощностей накачки, от 12 до 21 мВт и от 4 до 60 мВт;
- $\bullet$  КПД диодов: красный 45%, зеленый 35%, синий 55%;